ULTRA-LOW EMITTANCE LIGHT SOURCE STORAGE RING WITH SHORT AND NORMAL LENGTH STRAIGHT SECTIONS IN A CELL

Koji Tsumaki JASRI/SPring-8 1-1-1 Kouto, Sayo, Hyougo, 679-5198

Abstract

We designed a ten-bend achromat cell. But since the number of straight sections of a ring consisting of ten-bend achromat cells is small, we have added a short straight section in a ten-bend cell by removing the sectupole magnets and rearranging the quadrupole magnets which are placed in the center of a cell. We have designed two storage rings, with and without long straight sections, having two straight sections in a cell. The emittance of the storage ring with no long straight section reaches 69.7 pm by radiation damping of undurators. The brightness of the radiation from the 4.5 m length undulator placed in a normal straight section and that of from the 2 m length undulator placed in a short straight section are 2.6×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) and 1.3×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) at 1Å wavelength with 200 mA beam current, respectively. The emittance of the storage ring having long straight sections becomes 49.5 pm with damping wigglers. The brightness of 2.9×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) and the brightness of 1.2×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) are obtained by the 4.5 m length undulator and 2 m length undulator, respectively. These results shows that we can get the bright radiation from a short length undulator placed in a dispersion section and we can construct many beamlines even a storage ring consisting of ten bend achromat cells.

通常の直線部に加えラティス中央に短直線部を設けた 放射光用低エミッタンスリングの検討

1. はじめに

第一世代の放射光リングの平均輝度を1とすると、 第二世代では数百倍から数千倍、さらに光源が偏向 電磁石からアンジュレータに代わった第三世代では 数千万倍から数億倍となった。さらに高輝度、高コ ヒーレンス、短パルスを求めて第四世代の XFEL が 実現し、ERL も開発中である。これらは第三世代ま での蓄積リングと異なりいずれも線形加速器をベー スにしている。理由は蓄積リングではこれらの特性 を持つ電子ビームは実現できないと考えられていた からである。しかし蓄積リングは、ビームの軌道安 定性が良い、平均輝度が高い、多様なフィリングパ ターンか可能である、ビームラインの数が多い、技 術的な完成度が高い、など多くの長所がある。その ため、蓄積リングで短パルスはともかく、超低エ ミッタンスのリングが出来れば、高輝度で空間コ ヒーレンスの高い放射光が可能になる。これらを目 的として超低エミッタンスが検討され、10 bend achromat cell からなる34 pm の超低エミッタンス を持つリングが現実的なパラメータで可能であり口、 平均輝度が ERL や場合によっては XFEL に匹敵す ることがわかった。

このラティスを SPring-8 蓄積リングに適用したところ、83 pm の超低エミッタンスリングが可能であることがわかった^[2]。しかしながら現在の SPring-8 蓄積リングの直線部の数が48カ所であるのに比べ、直線部の数が24カ所と少ないのが欠点である。そこでセル中央の六極電磁石を取り除き、四極電磁石を脇によせ、短い直線部を持つラティスを設計し、

特性を検討した。

設計したリングは、長直線部のない24セルのものと SPring-8 と同じ4箇所の長直線部のあるリングの2種類である。それぞれについてダイナミックアパーチャ、得られる輝度などを検討したのでその結果について報告する。

2. 10 bend ラティス

エミッタンスは偏向電磁石の数の3乗に逆比例す るため、低エミッタンスにするにはできるかぎり偏 向電磁石の数を多くし、偏向電磁石中でビームを 絞ってやれば良い。しかしビームを絞ると色収差が 大きくなる上、偏向電磁石数が増すとディスパー ジョン関数が小さくなるため、色収差を補正する六 極電磁石が強くなりリングの非線形性が増し、ダイ ナミックアパーチャが小さくなると言う問題がある。 そのためエミッタンスが小さくて、かつダイナミッ クアパーチャがそれなりにあるリングを現実的なパ ラメータで設計できるかがポイントになる。そのた めには1セルあたりの偏向電磁石の数を出来る限り 増やしてかつ偏向電磁石の中でビームを強力に絞り、 エミッタンスを小さくするとともに、できるかぎり 磁石強度の弱いリングにしてダイナミックアパー チャを大きくするという相矛盾した要求を満たさな ければならない。図1にこれらの要求を満たした10 bend achromat cell とオプティカル関数を示す[1]。セ ルの長さは60 mで直線部の長さは6.56 mである。 四極電磁石、六極電磁石のボア径は 40 mm で磁場の 強さはそれぞれ 50 T/m と 3000 T/m²を上限として磁 石の長さを決めラティスを設計した。

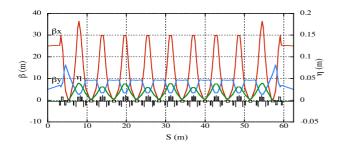


図1:10 bend achromat cell とオプティカル関数

3. 長直線部を持たないリング

3.1 ラティス

セル中央の偏向電磁石間の距離はもとのラティスでは4.78 mで、この間に3個の六極電磁石と4個の四極電磁石がある。六極電磁石を取り除き、四極電磁石をわきによせただけでは十分な直線部の長さが得られないため、元の直線部の長さを6.56 mから6 mにして、0.56 m分だけ短直線部に回し、短直線部の長さ3 mを確保した。図2に1セルの構造とオプティカル関数を、表1に主なパラメータを示す。

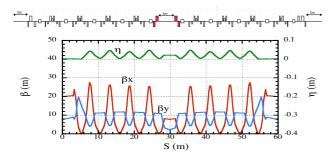


図2:中央に短直線部を持つセルの磁石配置とオプ ティカル関数

表1:蓄積リングの主なパラメータ

パラメータ		値
エネルギー	Е	6 GeV
エミッタンス	$\boldsymbol{\mathcal{E}}_{0}$	85.5 pm
周長	Lc	1436 m
セル数	Nc	24
チューン	v_x/v_y	110.30 / 31.28
色収差	ξ_x/ξ_y	401 / 86
モーメンタムコンパション	α	1.6×10^{-5}
エネルギー幅	σ_{e}/E	1.03×10^{-3}
RF 電圧	Vrf	8 MV
バンチ長	$\sigma_{\!_{l}}$	1.46 mm/ 4.87 pm
直線部長さ	Ls	6.0 m/ 3.0 m

3.2 ダイナミックアパーチャ

図3に直線部におけるダイナミックアパアーチャを示す。改善前は色収差補正だけの場合、改善後はハーモニック補正により幾何収差も補正した場合を示す。ダイナミックアパーチャは5 mm 程度あり低エミッタンスの電子ビームを入射するのに十分な大きさである。

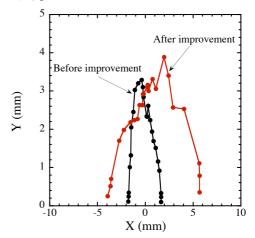


図3:長直線部を持たないリングのダイナミックア パーチャ

3.3 縦方向の安定性

低エミッタンスリングはモーメンタムコンパクションファクターが $1.6x10^{-5}$ と小さく縦方向の安定領域が小さくなるおそれがある。そこで縦法の安定領域を計算した。結果を図 4 に示す。高次のモーメンタムコンパクション [3] はシミュレーションプログラム cetra で計算したものを使用した [4] 。図 [3] (a) は最低次の α_0 だけ考慮した場合、図 [3] (b) は α_0 から α_4 まで考慮した場合である。ただし、 α_0 から α_4 までの値はそれぞれ次の通りである。 $[1.6x10^{-5}]$, $[1.7x10^{-4}]$, $[1.4x10^{-3}]$, $[-2.5x10^{-2}]$, $[-2.5x10^{-1}]$ 。高次まで考慮するとポテンシャルの形は歪むが、" α バケット"にはならず [3] にはならず [3] にはなり [3] にはならず [3] にはなりが [3] にはなり [3]

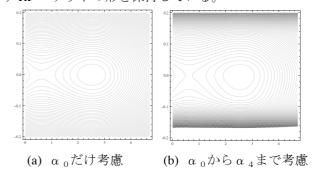


図4:縦方向の安定性

3.4 輝度

24 カ所の 6 m の直線部のうち 2 カ所を RF 空洞 設置のために、1 カ所を入射に使用するとし、24 カ所の 3 m の短直線部のうち一カ所はモニターを設

置するとすると、6 m の直線部には21個のアンジュレータが、3 m の直線部には23個のアンジュレータが設置できる。アンジュレータパラメータ K を 1.34、周期長を 1.8 cm とするとアンジュレータによるエネルギーロスは 2.0 MeV となり、偏向電磁石によるエネルギーロス 4.6 MeV と合計して 6.6 MeV のエネルギーロスとなる。

6 m の直線部に周期長 1.8 cm 長さ 4.5 m のアン ジュレータ ID1 を 2 1 個、 3 m の直線部には周期長 は同じく 1.8 cm で長さが 2.0 m のアンジュレータ ID2 を 2 3 個設置するとするとすべてのアンジュ レータギャップを閉じると、エミッタンスは85.5 pm から 69.7 pm に、エネルギー幅は 0.00103 から 0.00101 となる。表 2 にアンジュレータに関係する 主な項目とその値を、表3にエミッタンスとエネル ギー幅をまとめて示す。表2と表3に示す条件で SPECTRA^[5]を用いて、放射光の輝度を計算した。た だし電流は200 mA を、カップリングは 0.2 %を 仮定した。結果を図5と図6に示す。これより 4.5 m のアンジュレータからはダンピングなしで最大 2.2×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW)、ダンピングがあ る場合は 2.6×10²² (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) の輝度 が得られることがわかる。また短直線部の2 m のア ンジュレータからはダンピングのない場合 1.2×10²² $(ph/s/mm^2/mrad^2/0.1\%BW)$ 、ダンピングがある場合 1.3×10²² (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW)の輝度が得られる。 このことから、ディスパージョンがあり長さの短い 直線部からでも 10²² (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) 台の 十分輝度の高い光が得られことがわかった。

表2:アンジュレータに関係する主な項目とその値

パラメータ	ID1	ID2
長さ	4.5 m	2.0 m
周期長	1.8 cm	1.8 cm
個数	21	23
βx / βy / η	20.0 m / 7.8 m / 0 m	7.8 m / 2.1 m / 0.02 m

表3:エミッタンスとエネルギー幅

	アンジュレー タなし	アンジュレータ あり
エミッタンス $ε_0$	85.5 pm	69.7 pm
エネルギー幅 ΔE/E	0.00103	0.00101

4. 長直線部を持ったラティス

4.1 ラティス

SPring-8 蓄積リングのビームラインと全く同じ位置と同じ数のビームラインになるように、長直線部のあるリングを設計した。この場合もセル中央の偏向電磁石間の六極電磁石を取り除き、四極電磁石をわきによせ通常の長さの直線部に加え、短い直線部を持つようにラティスを設計した。オプティカル関

数を図7に、主なパラメータを表4に示す。

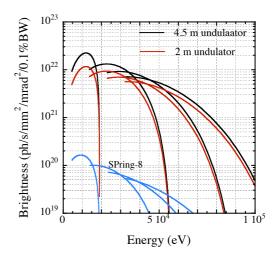


図5:ダンピングを考慮しない場合のアンジュレータからの放射光スペクトル

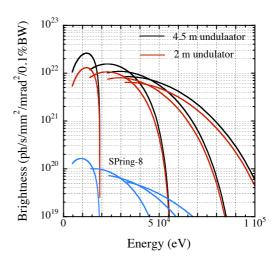


図 6: ダンピングを考慮した場合のアンジュレータ からの放射光スペクトル

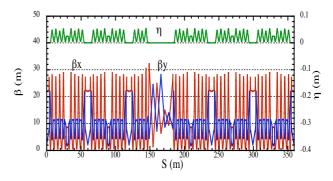


図7:1/4周分のオプティカル関数

表4:長直線部を持つ蓄積リングの主なパラメータ

パラメータ		値
エネルギー	E	6 GeV
エミッタンス	$\boldsymbol{\mathcal{E}}_{0}$	107.7 pm
周長	Lc	1436 m
セル数(10bend/5bend/長直線)	Nc	20 / 4 / 4
チューン	v_x/v_y	104.44 / 34.45
色収差	ξ_x/ξ_y	413 / 91
モーメンタムコンパション	α	$1.7x10^{-5}$
エネルギー幅	$\sigma_{\!\scriptscriptstyle e}/E$	1.08×10^{-3}
RF 電圧	Vrf	16
バンチ長	σ_{l}	1.04 mm/ 3.45 pm
直線部長さ	Ls	6.6 m/ 2.5 m

4.2 ダイナミックアパーチャ

図8にハーモニック補正前と補正による改善後のダイナミックアパーチャを示す。長直線のない場合に比べダイナミックアパーチャが小さく補正後もあまりアパーチャが大きくなっていない。まだ補正が十分でなくアパーチャ改善の余地があるのかも知れない。

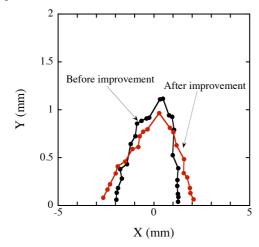


図8:長直線部を持つリングのダイナミックアパーチャ

4.3 縦方向の安定性

図 9 に縦方向の安定領域の計算結果を示す。図 9 (a) は最低次の α_0 だけ考慮した場合、図 9 (b) は α_0 から α_4 まで考慮した場合である。ただし、 α_0 から α_4 までの値はそれぞれ次の通りである。 $1.7x10^5$, $1.9x10^4$, $-1.4x10^3$, $-5.9x10^2$, $6.2x10^1$ 。高次まで考慮すると長直線部を持たないリングと同じくポテンシャルの形は歪むが、RF バケットの形は保持している。

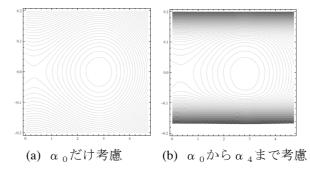


図9:縦方向の安定性

4.4 輝度

20箇所の通常の長さの直線部のうち3カ所をRFのために、1箇所を入射のために使用すると残り16箇所がアンジュレータ用に使用できる。また20箇所の短直線部のうち1箇所はビーム診断用とする。また長直線部には通常のアンジュレータかダンピングウイグラーを置くものとする。16箇所の通常の直線部には、長さ4.5 m周期長1.8 cmのアンジュレータを、19箇所の短直線部には長さ2 m周期長1.8 cmのアンジュレータを、4箇所の長直線部には1直線部あたり6個の4.5 m長のアンジュレータかダンピングウイグラーを置くものとする。これらの主な数値を表5に、またこれらの挿入光源を入れた場合のエミッタンスとエネルギーを表6に示す。

偏向電磁石によるエネルギー損失は 5.0 MeV、直線部すべてにアンジュレータを置いた場合のエネルギー損失は 3.2 MeV、長直線部にウイグラーを、他はアンジュレータとした場合、ウイグラーによるエネルギー損失は 5.5 MeV、アンジュレータによるものは 1.6 MeV である。これよりエネルギー損失は最大 12.2 MeV となるため、RF 電圧は 16 MV とした。

図 1 0 と図 1 1 に電流 200 mA、カップリング 0.2%を仮定した時のダンピングを考慮しない場合と 考慮した場合の放射光のスペクトルを示す。これよりダンピングなしとした場合でも 4.5 m のアンジュレータからは最大 1.9×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW)、ダンピングがある。また短直線部の 2 m のアンジュレータからは ダンピングの ない場合 0.95× 10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW)、ダンピングがある場合 1.2× 10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW)、ダンピングがある場合 1.2× 10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW)の輝度が得られることが分かる。このことから、ディスパージョンがあり長さの短い直線部からでも長直線部を持たない時と同様に 10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) 台の十分輝度の高い光が得られことがわかる。

表 5:アンジュレータおよびダンピングウイグラー に関係する主な項目とその値

	ID1	ID2	ID3
 長さ	4.5 m	2.0 m	4.5 m
周期長	1.8 cm	1.8 cm	5 cm
個数	16	19	24
βx / βy	21.9 m / 2.1 m	8.5m / 1.7 m	8 m- 17 m
η	0 m	0.02 m	0 m

表6:エミッタンスとエネルギー幅

	IDなし	ID1+ID2	ID1+ID2+ID3
エミッタンス ϵ_0	107.7 pm	72.8 pm	49.5 pm
エネルギー 幅 ΔE/E	0.00108	0.00104	0.00121

5. まとめ

1セルの長さ60 mの10 bend セル中央の六極電磁石を取り除き、四極電磁石を両側によせて、短い直線部を持つラティスを設計した。設計は長直線部を持たない24回対象リングと4箇所の長直線部を持つリングについて行ない、それぞれ自然エミッタンス85.5 pmと107.7 pmが得られた。短直線部の長さは約3 mで、この部分には約0.02 mのディスパージョンが存在する。通常の直線部には長さ4.5 mのアンジュレータを、短直線部には長さ2 mのアンジュレータをおき、長直線部には長さ2 mのアンジュレータをおき、長直線部には長さ2 mの対してはさらに長直線部にダンピングにより、長直線部を持たないリングのエミッタンスは69.7 pm、直線部を持つリングのエミッタンスは49.5 pmとなることがわかった。

ビーム電流 200 mA、カップリング 0.2%を仮定し放射光の輝度を計算した。長直線部を持たないリングでは 4.5 m のアンジュレータからは 1Å で 2.6×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) の輝度をもつ放射光が得られ、短直線部の 2 m のアンジュレータからは 1.3×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW)の輝度の放射光が得られることがわかった。また長直線部を持つリングでは 4.5 m のアンジュレータから 1 Å で 2.9×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW) の輝度の放射光が得られ、短直線部の 2 m のアンジュレータからは 1.2×10^{22} (ph/s/mm²/mrad²/0.1%BW)の輝度の放射光が得られることがわかった。これより、ディスパージョンのある短い直線部でも十分高輝度な放射光が得られ、1 0 bend ラテョスの通常の長さの直線部の数が少ないという欠点が解消できることがわかった。

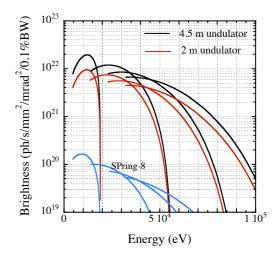


図10:ダンピングを考慮しない場合のアンジュ レータからの放射光スペクトル

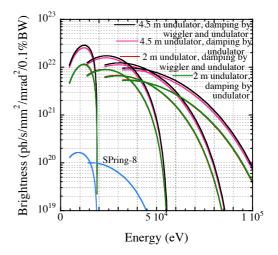


図11:ダンピングを考慮した場合のアンジュレー タからの放射光スペクトル

参考文献

- [1] K. Tsumaki, N. Kumagai, "Very low emittance light source storage ring", Nucl. Instr. and Meth. A 565 (2006) 394.
- [2] K. Tsumaki, N. Kumagai, "NEXT GENERATION LIGHT SOURCE STORAGE RING AT SPring-8", EPAC'06, Edingburg, 2006, p.3362.
- [3] H. Tanaka et. al., "Aperturbative formulation of nonlinear dispersion for particle motion in storage rings", Nucl. Instr. and Meth. A 431 (1999) 396.
- [4] J. Schimizu et. al., "DEVELOPMENT OF A TRACKING AND ANALYSIS CODE FOR BEAM DYNAMICS IN SPring-8", The 13th Symposium on Accel. Sci. and Tech., Osaka,2001, p.80.
- [5] T. Tanaka, http://radiant.harima.riken.go.jp/spectra/